

XN-0119 (2009/06/12)

تنظیم - گاف در گرافن

شاهد مستقیمی به دست آمده از این که می‌شود گاف انرژی در یک نمونه ی گرافن - دولایه‌ای را با ولتاژ کنترل کرد. این بر خلاف وضع نیمرسانانها ی معمولی (مثل سیلیسیم) است، که گاف انرژی ی آن‌ها با ساختار بلوری و ترکیب شیمیایی تعیین می‌شود. در یک آزمایش توانسته اند با تغییردادن ولتاژ خارجی بین صفر و 250 mV در دما ی اتاق، گاف انرژی ی یک نمونه ی گرافن - دولایه‌ای را تنظیم کنند [1].

[1] Nature **459** 820